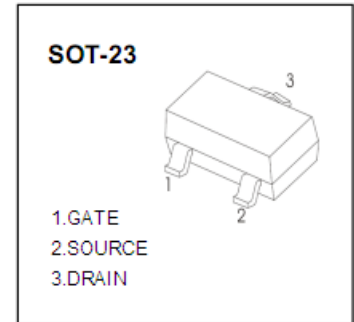
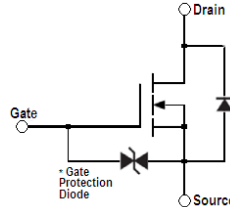


**2SK3018** MOSFET ( N-Channel )**印章/MARKING: KN****特点/Features :**

- 1、低导通电阻；
- 2、开关速度快；
- 3、低电压驱动；

**用途/Applications :**

用于一般开关电路。

**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
源极-漏极电压/Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	30	V
栅极-源极电压/Gate-Source Volotage	$V_{GSS}$	$\pm 20$	V
漏极电流 (持续) /Continuous Drain Current	$I_D$	0.1	A
耗散功率/Power Dissipation	$P_D$	0.35	W
热阻/ Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	350	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

**电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极-漏极击穿电压	$V_{BR(DSS)}$	$V_{GS}=0V, I_D=10\mu A$	30			V
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$I_D=100\mu A, V_{DS}=3V$	0.8		1.5	V
栅极漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$			$\pm 500$	nA
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{GS}=0V, V_{DS}=30V$			0.2	$\mu A$
漏极导通电流	$I_{D(ON)}$	$V_{GS}=10V, V_{DS}=7V$	500			mA
漏极源极导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4V, I_D=10mA$			8	$\Omega$
		$V_{GS}=2.5V, I_D=1mA$			13	
正向跨导	$g_{fs}$	$V_{DS}=3V, I_D=10mA$	20			ms
漏极-源极导通电压	$V_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=500mA$	0.5		3.75	V
		$V_{GS}=5V, I_D=50mA$	0.05		0.375	V
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1MHz$		13		pF



**SOT-23 封装半导体场效应管/SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS**

输出电容	$C_{oss}$	$V_{GS}=5V, V_{DD}=5V, I_D=10mA,$ $R_g=10\Omega, R_L=500\Omega$	9	
开启时间	$t_{(on)}$		15	ns
上升时间	$t_r$		35	ns
关闭时间	$t_{(off)}$		80	ns
下降时间	$t_f$		80	ns

**典型特性曲线图/Typical Characteristics**

